

[English Translation of Excerpt from Reference 4]

Laid-Open Japanese Patent Application H01-260829 A

Laid-Open Date: October 18, Year of Heisei-01 (1989)

Number of Claims: 1; (Gazette in 5 pages)

[Title of Invention] SEMICONDUCTOR MANUFACTURING EQUIPMENT

Japanese Patent Application S63-088218

Filing Date: April 12, Year of Showa-63 (1988)

Inventor: Koichi HASHIMOTO [JP]

Applicant: Fujitsu, Ltd. [JP]

--- (omitted) ---

[Claim]

[Claim 1] A semiconductor manufacturing equipment, wherein a wet etching device for etching a semiconductor substrate or a metal membrane, semiconductor membrane, insulation membrane or the like on a semiconductor substrate using a liquid etching agent is characterized in that the device comprises:

a spraying port (15) for spraying the liquid etching agent at substantially the same direction and the same strength over a substantially identical area to an area for etching; and

a mechanism for rotating a semiconductor substrate so that a liner speed thereof at any location within said range can be made slower than the speed of the liquid etching agent being sprayed from the spraying port (15).

--- (omitted) ---

Among various wet etching devices of prior arts, it is a single wafer-type spinning etching device that can meet various requirements in the step of etching, such as favorable distribution within a wafer, good reproducibility among wafers, possibility to detect an end point, possibility to rapidly suspend etching, etc.

--- (omitted) ---

[Means for Solution of Problem]

According to the present invention, etching is run under such an adopted constitution that a liquid etching agent is sprayed with a nozzle so that the sprayed liquid etching agent can be directed substantially in parallel and evenly, and a wafer is rotated at a slower speed than the speed of the sprayed liquid etching agent flowing even at any peripheral portion of the wafer.

Namely, when the radius of a wafer is expressed as r , the angular velocity is expressed as ω , and the velocity of a flowing liquid etching agent is expressed as v , the wafer should be rotated to meet the following requirement: $r \cdot \omega < v$.

(Function)

According to the method of the present invention, said problem can be solved as follows:

First, although an etching rate can be dependant upon the supply rate of a liquid etching agent to each location of a wafer as well as its flowing speed on the surface, the evenness of the supply within the [area of a] wafer is secured according to the present invention by the shape of a nozzle, and the flowing speed on the surface can become even within the [area of a] wafer because a flow at the time of spraying is not significantly disturbed by the rotation [of a wafer]. Accordingly, the evenness of an etching rate can be secured within the [area of a] wafer.

--- (omitted) ---

[Brief Description of Figures]

Figure 1 is an explanatory chart for an example of the present invention, Figure 1(a) being a front view of a nozzle, and Figure 1(b) showing a total constitution.

Figure 2 is an explanatory chart for the principle of the present invention.

Figure 3 is a cross sectional view of a trench formed on a semiconductor substrate.

Figure 4 is a constitutional chart for a spin etching device of prior art.

Figure 5 is a chart showing the etching of a wafer.

[Code Explanation]

(11) Wafer; (2) Pin; (3) Arm; (4) Shaft; (5) Nozzle; (6) Liquid etching agent; (12) Pin; (13) Arm; (14) Shaft; (15) Nozzle; (17) Hole; (16) Liquid etching agent; (31) Silicon substrate; (32) Trench; (33, 34) SiOx membrane; (35) Silicon nitride membrane; (36) Polycrystalline silicon; (41) Wafer; (41a) Wafer's rotary center; (42) Chip; (42a, 42b) Chip; (43) Pattern; and (44) Hole.

⑫ 公開特許公報(A)

平1-260829

⑤Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬公開 平成1年(1989)10月18日

H 01 L 21/306

R-7342-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

⑭発明の名称 半導体製造装置

⑮特 願 昭63-88218

⑯出 願 昭63(1988)4月12日

⑰発 明 者 橋 本 浩 一 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内

⑱出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

⑲復代理人 弁理士 大宮 義之

明 細 書

1. 発明の名称

半導体製造装置

2. 特許請求の範囲

エッチング液を用いて半導体基板、半導体基板上の金属膜、半導体膜、絶縁膜などをエッチングするウェットエッチング装置にして、

エッチングする範囲とほぼ一致する範囲においてほぼ一様な方向と強さのエッチング液を噴霧する噴霧口(15)を有し、前記範囲のいずれの点でもその線速度が該噴霧口(15)から噴霧されたエッチング液(16)の速度に比べてより小になるように半導体基板を回転させる機構を有することを特徴とする半導体製造装置。

3. 発明の詳細な説明

〔概要〕

半導体製造装置、特に半導体装置の製造におい

てウェットエッチングを行う製造装置に関し、

一般にエッチングレートがバターンの方向によらず、かつ、エッチングレートのウエハ内分布の良いウェットエッチング装置を提供することを目的とし、

エッチング液を用いて半導体基板、半導体基板上の金属膜、半導体膜、絶縁膜などをエッチングするウェットエッチング装置にして、エッチングする範囲とほぼ一致する範囲においてほぼ一様な方向と強さのエッチング液を噴霧する噴霧口を有し、前記範囲のいずれの点でもその線速度が該噴霧口から噴霧されたエッチング液の速度に比べてより小さくなるように半導体基板を回転させる機構を有することを特徴とする半導体製造装置を含み構成する。

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体製造装置、特に半導体装置の製造においてウェットエッチングを行う製造装置に関する。

(従来の技術)

近年、半導体集積回路の規模は急速に増大しており、集積度の向上が強く望まれている。そのためトランジスタに代表される能動素子のみならず、素子分離領域の微細化が是非とも必要となっている。従来から用いられている素子分離法は、シリコンLSIの場合、シリコンの選択酸化によって形成する SiO_2 を用いる誘電体分離法である。しかしこの方法では、いわゆるバズビーク(bird's beak)による能動領域幅の減少や、CMOS構造のウェル分離におけるラッチアップ現象の問題など、分離領域の幅を小さくすることに限界があった。

そこで現在開発されつつあり、また一部実用化されている技術としてトレンチ分離技術がある。この方法は、第3図を参照すると、シリコン基板31に適当な深さの溝32を形成し、この内部に誘電体ないし誘電体と半導体の積層膜からなる充填材を埋め込んで素子間を分離するものである。なお同図において、33は溝の側壁上に形成された SiO_2 膜、34と35は溝のエッチングのときにマスクとし

て用いる SiO_2 膜と窒化シリコン膜である。かかる溝を形成した後に例えばポリシリコン36を例えば化学気相成長(CVD)法で破線以示す位置まで成長し、次いでポリシリコンを矢印方向にエッチングして実線以示すところでエッチングを止め、溝32をポリシリコン36で埋め込む。そして、このトレンチ内に充填材を埋め込む製造工程で、選択性の良さ、ダメージが少ないことなどから、ウエットエッチを用いてエッチバックする方法が有力視されている。

従来のウエットエッチング装置のうち、エッチバック工程において要求されるウエハ内分布が良いこと、ウエハ間の再現性が良いこと、エンドポイント検出が可能で急速なエッチングの停止が可能であるなどの条件を満たすのは、枚葉式のスピネッチャーである。

第4図は従来のスピネッチャーの構成図である。半導体基板1を、ピン2と腕3および軸4からなるチャックで保持し、これを800rpm程度の速度で回転させながら、噴霧口(ノズル)5から

エッチング液6をスプレーしてエッチングを行う。なおこの図で、裏面に付着したポリシリコンを同時にエッチングするためのノズルと、エンドポイント検出用の光学系は省略した。

この構成のスピネッチャーでは、ウエハ内のエッチングレートの均一性を確保するために、800rpm程度の比較的高速の回転を必要とする。

(発明が解決しようとする課題)

従来の装置によるエッチング中には、ウエハ表面に半径方向のエッチング液の流れを生じる。このためエッチバックが完了した後、残渣がないよう若干のオーバーエッチを行う際、溝の方向が半径方向に対してほぼ平行なパターンにおいて、その溝内のエッチングレートが他の部分に比べて速く、エッチバックによる埋込み工程完了後の基板表面の平坦性を損なうという問題があった。

第5図はウエハのエッチングを示す図で、本発明者は、ウエハ41にチップ42a、42bのレジストパターンを形成した。チップ42aは図に見てウエ

ハの回転中心41aの真下に、またチップ42bは回転中心の左に設けた。パターン43は第3図の溝32と同じ溝パターンであり、また44は実験のために形成した溝と同じ深さの円筒状の穴(円形パターン)で、溝と穴にはポリシリコン45が埋め込まれている。かかるパターンを用い、第4図のスピネッチャーを用い800rpmの回転速度でウエハ41上に成長したポリシリコンをエッチングをしたところ、ウエハの下方のチップ42aでは、ウエハの下方の断面図で示されるように溝43内のポリシリコン45はオーバーエッチングされ、左のチップ42bではポリシリコンはウエハの左の断面図に示されるように溝43の表面がウエハ面と同一平面にあるようにエッチングされた。また、双方のチップ42a、42bにおいて、穴44ではポリシリコンがウエハ表面とほぼ同じ高さにエッチングされた。この現象から、本発明者は、ウエハ41が800rpmの回転速度で回転するとき、エッチング液は遠心力によって図に白抜矢印で示す方向に飛ばされ、そこで、エッチング液の飛ばされる方向と溝パターン

の方向とが一致するところ(チップ42a)ではエッチングが早く進み、溝パターン方向が矢印方向と直交するところ(チップ42b)ではエッチングが遅く進むであろう、と推論した。そして、穴のポリシリコンは双方のチップで同じ深さにエッチングされたことは、この推論を裏付けるものと思われる。

そこで本発明は、一般にエッチングレートがパターンの方向に依らず、かつ、エッチングレートのウエハ内分布の良いウエットエッチング装置を提供することを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

本発明では、エッチング液のスプレーされたものが、ウエハの全面においてその方向がほぼ平行かつ均一になるようなノズルを用いてスプレーし、ウエハの周辺部においてもスプレーされたエッチング液の流れの速さよりも遅くなるような速度でウエハを回転させてエッチングを行う構成を採用する。

ン依存性がない。

本発明の原理を示す第2図を参照すると、チップ42が形成されるウエハ41は、半径 r としたとき、角速度が ω であれば、チップの周辺では $r \cdot \omega$ の矢印で示す線速度が発生する。このウエハ41に向けて v の速度でエッチング液がスプレーされたとき、 $r \cdot \omega \gg v$ であれば第5図を参照して説明した現象が発生するのであるが、 $r \cdot \omega < v$ とするときには、ウエハ41が矢印1'の方向に回転しても、エッチング液は常に破線矢印の方向に流れ、1個のチップについていうと、あるときはエッチング液の流れ方向が溝パターンと平行であり、次の時点ではエッチング液の流れ方向は溝パターンと直交する。すなわち、各チップの溝パターンとエッチング液の流れ方向とは、すべてのチップについて平均的に変化するもので、総体的にみると両者は均一化し、すべての溝内のポリシリコンが平均的にエッチングされることになる。

〔実施例〕

すなわち、ウエハの半径を r とし、ウエハ回転の角速度を ω 、スプレーされたエッチング液の流れの速度を v とするとき、 $r \cdot \omega < v$ の条件を満たすように回転させる。

〔作用〕

本発明の方法によると、次のようにして前記問題点が解決できる。

先ず、エッチングレートは、ウエハ各点におけるエッチング液の供給量とその表面上での流れの速さによるが、本発明の構成では、供給はノズル形状によってウエハ内で均一性を確保し、表面上での流れの速さは、スプレーされた時点の流れが回転によってあまり乱されないため、ウエハ内で均一となる。従ってウエハ内のエッチングレートの均一性が確保できる。

次に、表面上での流れの方向が各瞬間ごとにはほぼ同一であり、これに対してウエハが回るから、ウエハ上のどの点でも、流れ方向の影響は平均化されて現れない。従って、エッチングレートのパター

以下、本発明を図示の実施例により具体的に説明する。

第1図は本発明の一実施例の説明図である。同図(a)はノズルの正面図であり、楕円形の面内に面密度が一定であるように孔17を開けたものである。ここで、楕円の長径 a はウエハの直径 d 以上とし、短径 b はノズルの角度を θ とすると、 $b = a \cdot \sin \theta$ を満たすようにする。また各孔17からの噴出量が一定であるように各孔17に至る圧力損がほぼ等しくなるように側面形状を整える。

同図(b)は全体の構成図である。ウエハ11をピン12、腕13、軸14よりなるチャックにより保持、回転しながら、上記ノズル15よりエッチング液16を噴霧してエッチングを行う。このとき、エッチング液16の流れはウエハ上のどの点においてもほぼ一定になり、回転速度を適当な速度としておくことによりパターン方向依存性は解消される。

なお、エッチング液の流量およびウエハ回転速度は、ノズルの孔の形や数などによって実験的に決める必要がある。なおそのとき、ノズルの角度

θ はエッチング液の流速 v に影響するから ($\theta = 0$ と $\theta = 90^\circ$ のときウエハ上のエッチング液の速度は v と 0 となる)、ノズルの角度も考慮しなければならない。

この実施例では楕円形のノズルに一定の密度で同じ大きさの孔を設けたが、流体力学的に孔の密度や大きさを変化させて一様性を確保してもよい。また、この実施例ではノズルは楕円形であったが、直線状に並んだ孔を用いてもノズル角度をうまく選べば同様な結果が得られる。また、この実施例では示さなかったが、エンドポイントの検出機構や裏面の同時エッチングを並置してもよい。

(発明の効果)

以上のように本発明によれば、パターンの方に依存することなくウエハ内で均一なエッチングレートを有するエッチング装置が得られ、従って、本発明の装置を用いれば高精度なエッチングが可能となり、半導体の製造歩留りおよび信頼性が向上する。なお、上記の例ではポリシリコンのエッ

チングについて説明したが、本発明の適用範囲はその場合に限定されるものでなく、半導体基板、半導体基板上の金属膜、半導体膜、絶縁膜などをエッチングする場合にも及ぶものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例の説明図で、その(a)はノズル正面図、(b)は全体の構成図、

第2図は本発明の原理を説明する図、

第3図は半導体基板に形成された溝の断面図、

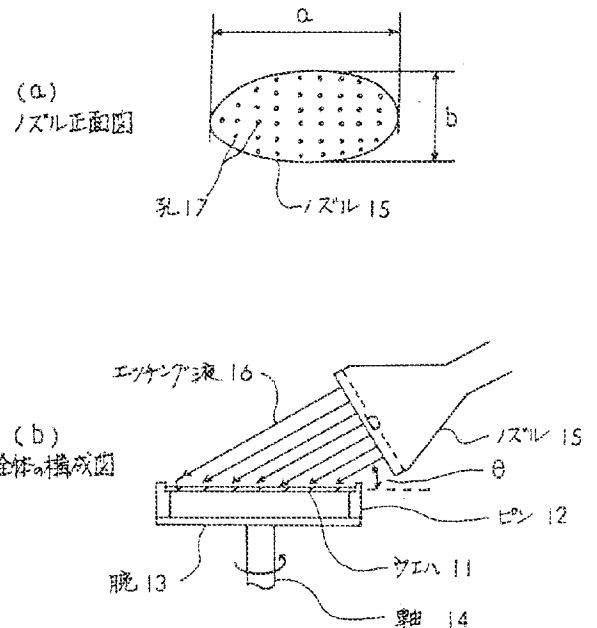
第4図は従来のスピネッチャの構成図、

第5図はウエハのエッチングを示す図である。

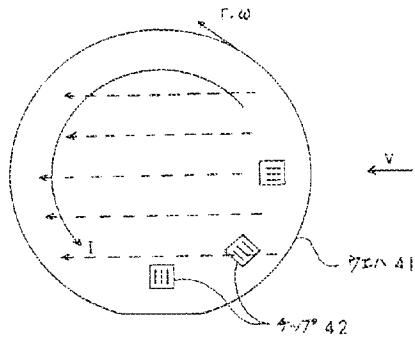
図中、
11はウエハ、
12はピン、
13は腕、
14は軸、
15はノズル、

16はエッチング液、
17は孔、
を示す。

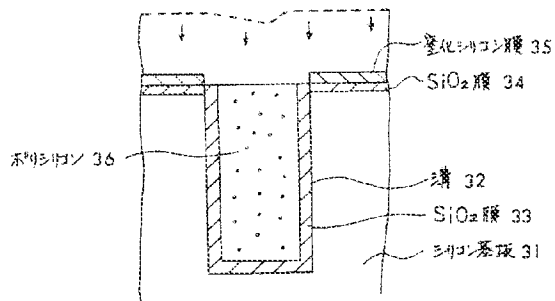
特許出願人 富士通株式会社
代理人弁理士 久木元 彰



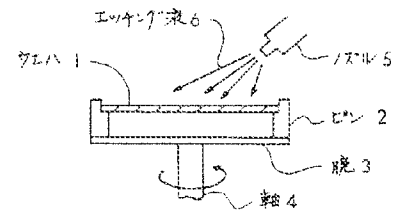
本発明実施例の説明図



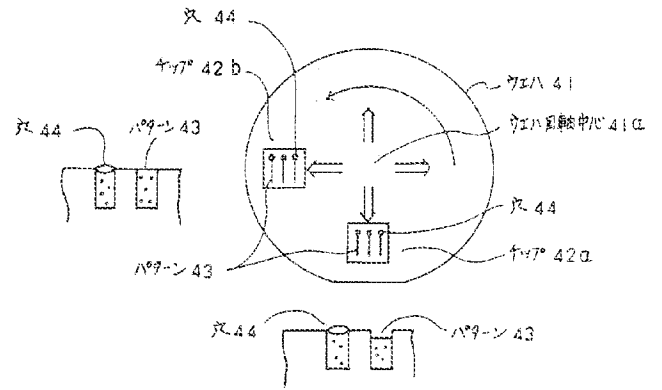
本発明の原理を説明する図
第2図



半導体基板に形成された溝の断面図
第3図



従来スピンエッチャの構成図
第4図



スピンのエッチャを示す図
第5図